

Параметры биполярных транзисторов

Тип БТ	Струк- тура	$h_{21Э\min} \dots$ $h_{21Э\max}$	$ h_{21Э} /$ на f , МГц	C_K , пФ	$C_Э$, пФ	I_{KB0} , мкА	$U_{KЭ\max}$, В	$I_{K\max}$, мА	$P_{K\max}$, Вт
КТ315Г	n-p-n	50...350	2,5/100	7	20	1	35	100	0,150
КТ337Б	p-n-p	40...100	5/100	5	5	1	-20	30	0,150
КТ342А	n-p-n	100...250	3/100	8	16	0,05	30	50	0,250
КТ347А	p-n-p	30...400	5/100	6	8	1	-20	50	0,150
КТ349Б	p-n-p	30...400	5/100	6	8	1	-20	20	0,200
КТ350А	p-n-p	20...200	5/20	70	100	1	-20	60	0,300
КТ351А	p-n-p	20...80	2/100	20	30	0,5	-20	30	0,225
КТ357А	p-n-p	20...100	3/100	7	10	5	-20	40	0,100
КТ358Б	n-p-n	10...100	4/20	5	15	10	30	30	0,100
КТ361Г	p-n-p	50...350	2,5/100	7	20	1	-35	50	0,150
КТ375Б	n-p-n	50...280	6/100	5	20	1	30	100	0,200
КТ3102Г	n-p-n	200...500	3/100	6	15	0,05	20	100	0,250
КТ3107Г	p-n-p	120...200	2/100	7	20	0,1	-25	100	0,300
КТ3117А	n-p-n	20...200	2,5/100	10	80	10	60	400	0,300
КТ814А КТ815А	p-n-p n-p-n	40...80	5/1	60	75	50	-10 10	1500	10
КТ816А КТ817А	p-n-p n-p-n	25...70	5/1	60	115	100	-25 25	3000	25
КТ818А КТ819А	p-n-p n-p-n	15...60	5/1	—	—	1000	-100 100	10000	60
КТ850А КТ851А	n-p-n p-n-p	40...200	5/1	—	—	100	-200 200	2000	25